



Capacitors

Resistors

Switches

Power Products

Magnetics Sensors

Active Components

## NEWS FLASH

### Gate Driver Cores für SiC MOS FET

#### Reduktion der Ausschaltverluste dank Augumented Switching®

Viele Hersteller arbeiten an der Entwicklung von Siliziumkarbid-Modulen und es wird viele Varianten von Gehäuseformen geben - einige mit Gehäusen, speziell entwickelt für den Betrieb von SiC Chips, wie zu Beispiel Fuji Electric und SanRex, andere Hersteller liefern SiC Module in Standard Gehäusen. Der neue Kern ermöglicht es, die AgileSwitch-Treibertechnologie mit diesen verschiedenen Siliziumkarbid-Modulen jeglicher Bauform zu betreiben.

Der Core wird mit einer Software geliefert, die es dem Kunden ermöglicht, Änderungen am Treiber selbst vorzunehmen, und es ist vorgesehen, Cores mit Standardeinstellungen ab Werk für die verschiedenen am Markt erhältlichen Module anzubieten.

Diese «Factory Settings» können dann mit Hilfe eines Programmers in der Applikation während dem Betrieb des Funktionsmusters, ohne Entfernen der Platine, direkt am Wechselrichter nach Bedarf angepasst werden und somit Eigenschaften wie EMV Abstrahlung, Wirkungsgrad, Kurzschlussfestigkeit etc. nach Bedarf optimiert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Flexibilität des Kerns mit seiner eingebauten Funktionalität und schnellen Software-Konfigurierbarkeit eine sichere und robuste Lösung für die Ansteuerung von Siliziumkarbid-Mosfet-Modulen in verschiedenen Anwendungen darstellt. Die AgileSwitch Augumented Switching™ -Technologie bietet den höchsten Wirkungsgrad und eine signifikante Reduzierung der Überspannung während Schalt- und Kurzschluss-bedingungen.